**Сведения о ведущей организации**

по диссертации Дроздова Дмитрия Геннадьевича «СВЧ комплементарный биполярный технологический процесс с высокой степенью симметрии динамических параметров транзисторов» по специальности 05.27.01 –Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах

Полное наименование: Федеральное государственное учреждение «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук»

Сокращенное наименование: ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН;

Адрес организации: 117218, Москва, Нахимовский просп., 36, к.1;

Телефон: (495) 718- 2110; (499) 124-9744;

Адрес электронной почты: niisi@niisi.msk.ru

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации:

1. Волков С.И., Волошина Е.П. Организация производства микроэлектронной продукции на технологическом комплексе НИИСИ РАН// Труды научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук. 2013. Т. 3. № 1. С. 6-9.
2. Амирханов А.В., Гладких А.А., Глушко А.А., Михальцов Е.П., Родионов И.А., Столяров А.А. Особенности метода проектирования СБИС с учётом результатов моделирования технологического процесса// Труды научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук. 2013. Т. 3. № 1. С. 10-19.
3. Глушко А.А., Юлкин А.С. Особенности оптимизации технологических режимов производства КНИ КМОП СБИС по критерию стойкости к воздействию спецификаторов// Труды научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук. 2013. Т. 3. № 1. С. 20-23.
4. Бабкин С.И., Волков С.И., Глушко А.А. КНИ МОП-Структура с непланарным контактом к карману// Труды научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук. 2013. Т. 3. № 1. С. 24-26.
5. Амирханов А.В., Гладких А.А., Глушко А.А., Макарчук В.В., Новоселов А.С., Родионов И.А., Шахнов В.А. Разработка парадигмы проектирования СБИС с учетом результатов конструкторско-технологического моделирования// Датчики и системы. 2013. № 9 (172). С. 38-51.
6. Аникин А.В., Дёмин С.В., Столяров А.А. Проблемы разработки и реализации базовых технологических процессов на технологическом комплексе НИИСИ РАН// Труды научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук. 2014. Т. 4. № 1. С. 6 – 16.
7. Морозов С.А., Соколов С.А., Фирсов А.С., Чистяков М.Г. Конструктивно-технологический базис библиотеки элементов с гарантированным уровнем радиационной стойкости не менее 1 Мрад// Труды научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук. 2014. Т. 4. № 1. С. 17-24.
8. Морозов С.А., Соколов С.А. Разработка радиационно-стойких микросхем и микромодулей статической памяти// Труды научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук. 2014. Т. 4. № 1. С. 25 – 31.
9. Епихин Е.Н., Масальский Н.В. 2D математическая модель подпорогового тока суб 20 нм двухзатворных КМОП транзисторах// Труды научно-исследовательского института системных исследований Российской академии наук. 2014. Т. 4. № 2. С. 123 – 130.
10. Амирханов А.В., Волков С.И., Глушко А.А., Зинченко Л.А., Макарчук В.В., Шахнов В.А., Юлкин А.С. Алгоритмы оптимизации ретроградного легирования кармана КНИ МОП-транзистора// В книге: Международная конференция "Микроэлектроника 2015" 2015. С. 217-218.
11. Глушко А.А. Применение оптимизации при калибровке моделей в системе приборно-технологического моделирования TCAD SENTAURUS//В сборнике: Будущее машиностроения России Сборник докладов Восьмой Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов. 2015. С. 385-388.
12. Амирханов А.В., Глушко А.А., Гладких А.А., Макарчук В.В., Шахнов В.А. Вопросы сопряжения системы приборно-технологического моделирования с библиотекой алгоритмов оптимизации//В книге: Международный форум "Микроэлектроника-2016" Тезисы докладов 2-ой научной конференции форума. 2016. С. 294-295.
13. Яшин Г.А., Амирханов А.В., Глушко А.А., Зинченко Л.А., Макарчук В.В., Михальцов Е.П. Моделирование процесса формирования LDD-областей субмикронных КНИ МОП-транзисторов в системе TCAD// В книге: Международный форум "Микроэлектроника-2016" Тезисы докладов 2-ой научной конференции форума. 2016. С. 165-168.
14. Амирханов А.В., Волков С.И., Глушко А.А., Зинченко Л.А., Макарчук В.В., Шахнов В.А. Оптимизация режимов ретроградного легирования кармана КНИ МОП-транзисторов СБИС// Микроэлектроника. 2016. Т. 45. № 4. С. 252-257.
15. Амирханов А.В., Глушко А.А., Гладких А.А., Макарчук В.В., Шахнов В.А. Разработка открытой платформы моделирования процесса проекционной оптической литографии// Наноиндустрия. 2017. Спецвыпуск (74). С. 407-408.